

а 2005 0233

Изобретение относится к полупроводниковой технике, в частности, к полупроводниковым газовым сенсорам.

Полупроводниковый газовый сенсор содержит подложку, на одну из поверхностей которой нанесен газочувствительный слой, а на противоположную поверхность – нагревательный элемент, при этом на газочувствительный слой нанесены металлические контакты. Новизна изобретения заключается в том, что на поверхности газочувствительного слоя образована область структуры в виде наноиглолок. Область структуры в виде наноиглолок может быть выполнена в виде кольца.

П. формулы: 1

Фиг.: 3